

「次世代電子デバイス教育研究開発拠点」

グローバルCOE特別セミナー

日時：平成21年6月30日（火） 17:00-18:30

会場：福井大学産学官連携本部3F研修室

演題：「SiCパワーデバイス開発の現状と課題
- Present Status and Prospects of SiC
Power Devices-」

講師：服部 亮 氏

三菱電機(株) 先端技術総合研究所

Dr. Ryo Hattori

Advanced Technology R&D Center,
Mitsubishi Electric Corp.

Abstract

地球規模の気象変動を背景に電力利用効率向上の鍵となる
ワイドギャップ半導体パワーデバイスの開発が急がれている。
本講演では、高電圧・高効率電力変換に期待されるSiCパワー
デバイスの開発の現状と課題を概説する。

問い合わせ先

福井大学大学院工学研究科電気・電子工学専攻
葛原 正明 TEL: 0776-27-9714(直通)